

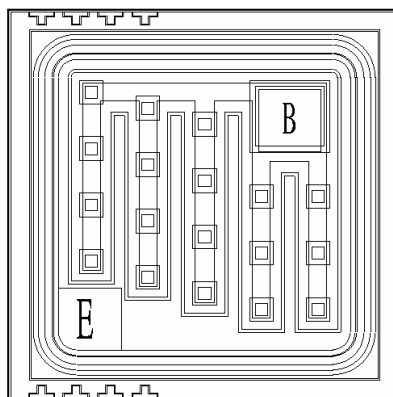


8550L 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A065BJ-00
芯片厚度：240 ± 20μm
管芯尺寸：650 × 650μm²
焊位尺寸：B 极 105×105μm²；E 极 105×105μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：S8550，H8550L

管芯示意图



极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
T_j——结温..... 150
P_C——集电极耗散功率..... 1W
V_{CBO}——集电极—基极电压..... -40V
V_{CEO}——集电极—发射极电压..... -25V
V_{EBO}——发射极—基极电压..... -6V
I_C——集电极电流..... -1.2A

电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{CB} =-35V，I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.1	μA	V _{EB} =-6V，I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	85 40		500		V _{CE} =-1V，I _C =-100mA V _{CE} =-1V，I _C =-800mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压			-1.0	V	V _{CE} =-1V，I _C =-10mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		0.2	-0.5	V	I _C =-800mA，I _B =-80mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-1.2	V	I _C =-800mA，I _B =-80mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	I _C =-100μA，I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	25			V	I _C =-2mA，I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =-100μA，I _C =0
f _T	特征频率	100			MHz	V _{CE} =-10V，I _C =-50mA